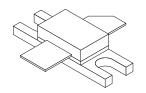


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-55С-1 Предназначен для работы в усилителях мощности до 3500 МГц

- Выходная импульсная мощность Рвых и = 100 Вт
- Напряжение питания U_{си} = 28 В
- Коэффициент усиления по мощности К_{ур} ≥ 9 дБ
- Длительность импульса τ_и = 300 мкс
- Скважность Q = 10



Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации								
Максимально допустимый ток стока	Іс макс	12	Α					
Максимально допустимый прямой ток затвора	Із (пр) макс	30	мА					
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	U си макс	80*	В					
Напряжение затвор-исток	Uзи	-10 до +2	В					
Максимально допустимая температура перехода	tп макс	225	⁰ C					
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	⁰ C					
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	R т п-к	**	⁰С/Вт					

^{*} Для всего диапазона рабочих температур

^{**} Уточняется в ходе проведения испытаний

Электрические параметры транзисторов									
Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), ⁰ С		
Остаточный ток стока	I _{C OCT}	U _{си} =80 В; U _{зи} =-8 В	-	-	25	мА	25±10		
Крутизна характеристики	S	I _c =6 А; U _{си} =10 В	5,6	6,8	-	A/B	25±10		
Ток стока	I_c	U _{си} =6 В; U _{зи} =2 В	23,3	28	-	Α	25±10		
Выходная импульсная мощность	Рвыхи	$\begin{array}{l} \text{f=2700 MFu;} \\ \text{U}_{\text{CM}} = 28 \text{ B;} \\ \text{P}_{\text{BXM}} = 12,5 \text{ BT;} \\ \text{I}_{\text{C}} = 0,1 \text{ A;} \\ \text{Q=10;} \tau_{\text{H}} = 300 \text{ MKC} \end{array}$	100	116	-	Вт	25±15		
Коэффициент усиления по мощности	K_{yp}	f=2700 MΓų; U_{CM} =28 B; P_{BbJX} =100 BT; I_{c} =0,1 A; Q=10; τ_{M} =300 MKC	9	10	-	дБ	25±15		
КПД стока	η_{c}	$\begin{array}{l} \text{f=2700 MFц;} \\ \text{U_{CM}=$28 B;} \\ \text{$P_{\text{BBJX,M}}$=$100 BT;} \\ \text{I_{c}=$0,1 A; Q=$10;} \\ \tau_{\text{M}} = 300 \text{ MKC} \end{array}$	60	65	-	%	25±15		

Габаритный чертеж

